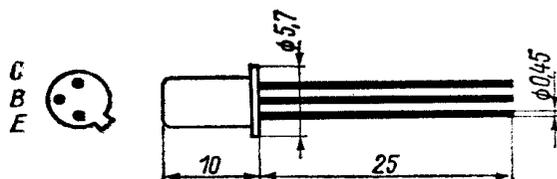


Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 mit hoher Basis-Emitter-Spannungsfestigkeit für mittlere Geschwindigkeiten in logischen Schaltungen.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO} = 20 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER} = 15 \text{ V}^1)$
$R_{BE} = 50 \Omega$	
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C = 200 \text{ mA}$
$t_{avL} = 20 \text{ ms}$	
Kollektorspitzenstrom	$\hat{-I}_C = 300 \text{ mA}$
Emitterstrom	$I_E = 200 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j = 85 \text{ °C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25 \text{ °C bis } +65 \text{ °C}$

Statische Kennwerte

	Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom			15 μA
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$			
$\vartheta_a = 25 \text{ °C}$			
Kollektor-Basis-Reststrom			80 μA
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$			
$\vartheta_a = 45 \text{ °C}$			
Kollektor-Basis-Reststrom			800 μA
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$			
$\vartheta_a = 75 \text{ °C}$			
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung			0,3 V
$-I_B = 9,4 \text{ mA}$			
$-I_C = 300 \text{ mA}$			
Basis-Emitter-Spannung			0,8 V
$-I_B = 9,4 \text{ mA}$			
$-I_C = 300 \text{ mA}$			
Kollektor-Basis-Stromverhältnis	h_{21E}	28	56
$-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$		45	90
$-I_C = 200 \text{ mA}$		71	140

Stromverstärkungsgruppe

Dynamische Kennwerte

Einschaltzeitkonstante	τ_i	1,2 μs
$-U_{CE} = 0,5 \text{ V}$		
$-I_C = 200 \text{ mA}$		
Speicherzeit	t_s	0,9 μs
$-I_B = 9,4 \text{ mA}$		
$-I_C = 300 \text{ mA}$		

Bemerkung:

Beim Umschalten des Transistors aus dem „Ein“-Zustand (max. Verlustleistung, $\hat{-I}_C = 300 \text{ mA}$) in den Sperrzustand ($-U_{CER} = 15 \text{ V}$, $R_{BE} = 50 \Omega$) darf die Widerstandsgerade zwischen beiden Schaltzuständen die Sperrkennlinie des Transistors nicht im negativen Widerstandsbereich schneiden.

Bestellbeispiel für einen Transistor
der Stromverstärkungsgruppe C

Transistor GS 112 C